大電流ドライブ用 ツェナーダイオード入りシリコンNPNエピタキシァル形

概要

2SC3728は、樹脂封止形シリコンNPNエピタキシァル形トランジスタです。 コレクタ損失が大きく、特にコレクタ電流を大きく設計、製造されており、コレクタ・エミッタ間にサージ吸収用のツェナーダイオードが内蔵されています。

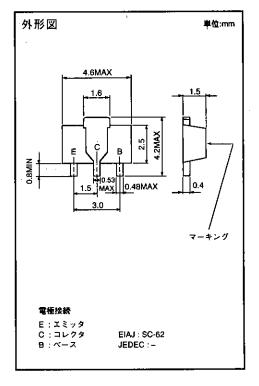
また、コレクタフィンが外部に出ており、基板に直接半田付することにより コレクタ許容損失が向上します。

特 長

- ●小形外形のためセットの小形化、高密度実装が可能
- ●コレクタ電流が大きい Ic=2A
- ●VCE(sat)が低い VCE(sat)=0.17V 標準 (@IC=1A/IB=50mA)
- ●hFEが高い hFE=150 ~ 800
- ●コレクタ損失が大きい Pc=500mW

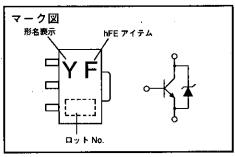
用途

カメラシャッタ、ソレノイドドライブ回路



最大定格 (Ta=25°C)

記号	項	目 定	格(直単位
Vcво	コレクタ・ベース間電	圧	- 20	V ·
VEBO	エミッタ・ベース間響	圧	6	
VCEO	コレクタ・エミッタ間	100年	12	
lc	コレクタ電流		2	A
Ісм	せん頭コレクタ電流		3	
P¢	コレクタ損失 (Ta=25	<u>5℃)</u>	500	
Tj	接合部温度		+150	°C
Tstg	保存温度	-	55 ~ +150	℃



電気的特性 (Ta=25℃)

記号	項目		.2011	_	42	件	特	性	値	単位
		測	定	宋	条 件	最小	標準	最大	│ [#] ╙│	
V(BR)CBO	コレクタ・ベー	・ス降伏電圧	lc=10 μ A,IE=0mA				20			V
V(BR)EBO	エミッタ・ベー	ス降伏電圧	le=10 μ A,lc=0mA		-		6			V
V(BR)CEO	コレクタ・エミ	ッタ降伏電圧	Ic=5mA,RвE≕∞				 12	14	16	V
Ісво	コレクタしゃ的	電流	Vce=16V,le=0mA						0.1	μΑ
IEBO	エミッタしゃ獣	電流	VEB=4V,Ic=0mA						0.1	μΑ
hre *	直流電流增幅率		VcE=4V,Ic=100mA				 150	350	800	
VCE(sat)	コレクタ・エミ	ッタ飽和電圧	lc=1A,le=50mA					0.2	0.35	.V
fτ	利得帯域幅積		Vce=2V,le=-10mA			<u>-</u>	40	80		MHz
Соь	コレクタ出力容	: =	Vcs=10V,IE=0mA, f=	1MHz				28		pF

*:hfe の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

マーキング	YE	YF	YG
hFE	150 ~ 300	250 ~ 500	400 ~ 800

安全設計に関するお願い -

・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

- 本資料ご利用に際しての留意事項 -

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有 の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三 菱電機は特性改良などにより予告なしに変更することがあります。従って、三菱半導体製 品のご購入に当たりましては事前に三菱電機または特約店へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機または特約店までご照会ください。